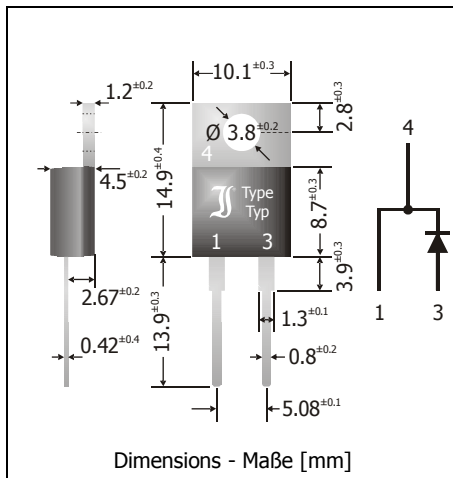


## PT800A ... PT800M

### Silicon Rectifier Diodes – Single Diode Silizium-Gleichrichterdioden – Einzeldiode

Version 2010-03-31



Nominal current Nennstrom	8 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	TO-220AC
Weight approx. Gewicht ca.	1.8 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging in tubes Standard Lieferform in Stangen	



#### Maximum ratings and Characteristics

#### Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung $V_F$ [V] <sup>1)</sup>	
			$I_F = 5$ A	$I_F = 8$ A
PT800A	50	50	< 1.0	< 1.1
PT800B	100	100	< 1.0	< 1.1
PT800D	200	200	< 1.0	< 1.1
PT800G	400	400	< 1.0	< 1.1
PT800J	600	600	< 1.0	< 1.1
PT800K	800	800	< 1.0	< 1.1
PT800M	1000	1000	< 1.0	< 1.1

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	8 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	$I_{FRM}$	30 A <sup>2)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	135/150 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	90 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	-50...+150°C -50...+175°C

1  $T_j = 25^\circ\text{C}$ 2 Max. temperature of the case  $T_C = 100^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur des Gehäuses  $T_C = 100^\circ\text{C}$

**Characteristics**

**Kennwerte**

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 10 $\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		$R_{thc}$	< 2.5 K/W

